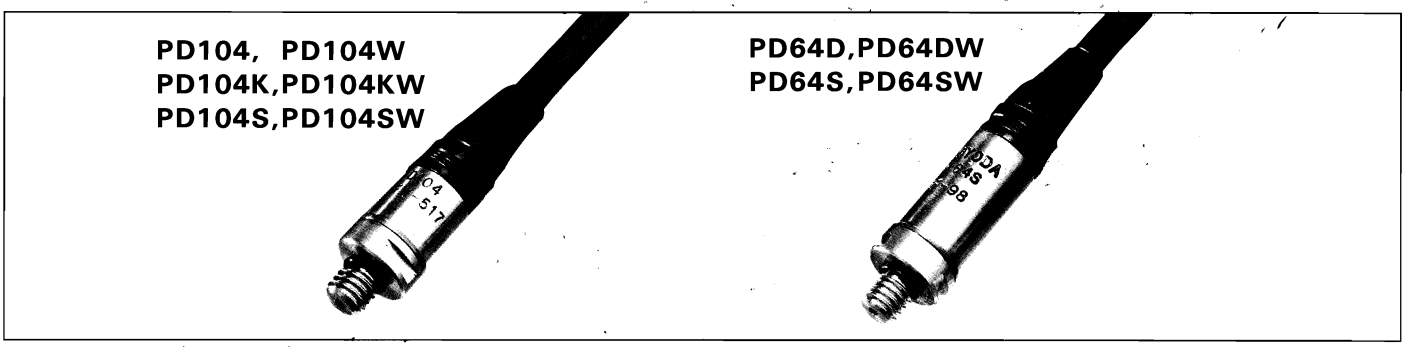
半導体圧力トランスデューサ SEMI-CONDUCTOR PRESSURE TRANSDUCERS

■ ゲージ圧トランスデューサ(拡散形、シリコンダイヤフラムタイプ)

拡散ゲージの片側を大気に開放したゲージ圧トランスデューサです。高い精度とすぐれた温度特性、安定性をもち、実験用、制御用、機器組み込み用など汎用性の高いトランスデューサです。

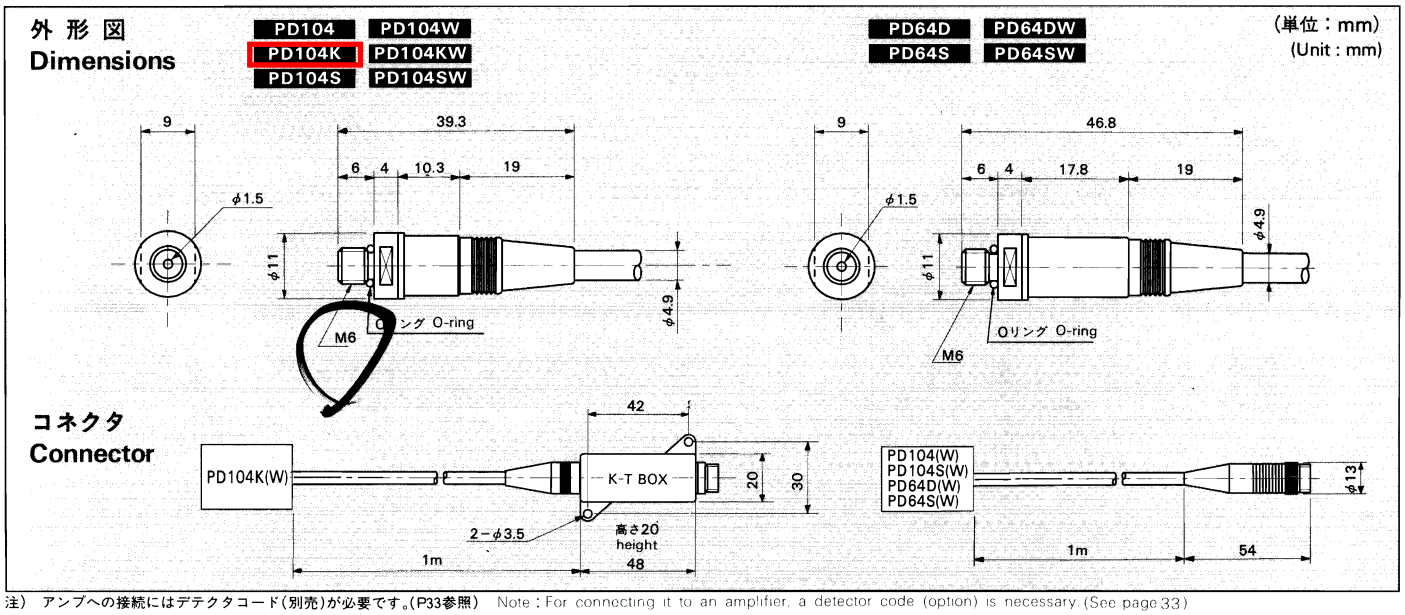
■ Gage Pressure Transducers(Diffusion Type, Sillicon Diaphragm)

These are gage pressure transducers with one side of the diffusion type gage opened to the atmosphere. Featuring high accuracy and good temperature characteristics and stability, these pressure transducers have a high level of non-specialized use, such as for laboratories and for being built into controller equipment.



仕様 Specifications ＼ 形式 Model	PD104	PD104W		PD64D		PD104K	PD104KW		PD104S	PD104SW		PD64SW	PD64S		
種別 Class	10K	30K	100K	300K	500K	10K	30K	100K	10K	30K	100K	300K	500K	1M	2M
定格圧力 Rated pressure Pa {kgf/cm²}	10K {0.10}	30K {0.30}	100K {1.0}	300K {3.1}	500K {5.1}	10K {0.10}	30K {0.30}	100K {1.0}	10K {0.10}	30K {0.31}	100K {1.0}	300K {3.1}	500K {5.1}	1M {10}	2M {20}
測定圧力範囲 Measurement pressure range Pa {kgf/cm²}	−10k～10k {−0.1～0.1}	−30k～30k {−0.30～0.30}	−100k～100k {−1.0～1.0}	−100k～300k {−1.0～3.1}	−100k～500k {−1.0～5.1}	−10k～10k {−0.1～0.1}	−30k～30k {−0.31～0.31}	−100k～100k {−1.0～1.0}	−10k～10k {−0.1～0.1}	−30k～30k {−0.31～0.31}	−100k～100k {−1.0～1.0}	−100k～300k {−1.0～3.1}	−100k～500k {−1.0～5.1}	−100k～1M {−1.0～10}	−100k～2M {−1.0～20}
過負荷 Overload (%)	150														
定格出力 Rated output (mV以上) (mV min.)	20	30	50		70	20	30	50	15	20	40	50	100	70	
許容温度範囲 Allowable temperature range (°C)	−40～100														
補償温度範囲 Compensation temperature range (°C)	−20～80														
零点移動温度特性 Zero drift temperature characteristics (%F.S./°C band width) (%F.S./°C バンド幅)	±0.08	±0.05	±0.03	±0.01		±0.03	±0.02	±0.01	±0.03	±0.02	±0.01			±0.02	
感度温度特性 Sensitivity temperature characteristics (%F.S./°C band width) (%F.S./°C バンド幅)	無補償 Without compensation					±0.03	±0.02	±0.01	±0.06	±0.04	±0.02				
非直線性 Non-Linearity (%F.S.以内) (within %F.S.)	±0.4	±0.3	±0.2		±0.9	±0.4	±0.3	±0.2	±0.5	±0.2			±0.9		±0.5
ヒステリシス Hysteresis (%F.S.以内) (within %F.S.)	±0.02			±0.1		±0.02			±0.1		±0.05		±0.1		
繰り返し精度 Repeatability (%F.S.以内) (within %F.S.)	±0.02			±0.1		±0.02			±0.1						
1次共振周波数 Natural frequency (kHz以上) (kHz min.)	6														
ブリッジ抵抗 Bridge resistance (kΩ at 24°C) (kΩ at 24°C)	1.6±0.25													1.5±0.7	
印加電源 Excitation voltage	DC6V					DC9V			DC4mA						
材質 Material	本体：SUS303 受圧部：シリコン Body : SUS303 (stainless steel) Diaphragm : silicon														
ケーブル Cable	ポリウレタン線1m（コネクタ付） Polyurethane cable : 1 meter (with connecter)														

※W付はシリコンゴムコーティング処理による防水仕様です。※W denotes those processed with silicon coating.



注） アンプへの接続にはデテクタコード(別売)が必要です。(P33参照) Note : For connecting it to an amplifier, a detector code (option) is necessary (See page 33)